

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ
И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

ПЛАЗМА ТМ200-01К

Назначение: Плазмохимическое травление поликристаллического кремния и нитрида кремния (мелкощелевая изоляция в кремнии).



Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле:
Ø 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагрев стенки реактора до 60°C;
- Гелиевое охлаждение и механический прижим пластин;
- Рабочие газы: Cl_2 , HBr , SF_6 , O_2 , CF_4 , He , N_2 .;
- Скорость анизотропного травления кремния не менее 0,5-1 мкм/мин;
- Мощность потребления не более 14 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

